

# Реєстраційна картка ДіР

## I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0110U004253

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-05-2011



## II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 5031080

| У тому числі по роках:                       |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| 2010                                         | 2900 тис. грн. |
| 2011                                         | 2900 тис. грн. |
| Загальний обсяг фінансування: 5800 тис. грн. |                |

## III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне агентство з питань електронного урядування України

Код за ЄДРПОУ: 37471818

Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, Київ, 03150, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2071730

## IV. Відомості про виконавця ДіР

**Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи):** Львівська філія науково-виробничого концерну "Наука"

**Код за ЄДРПОУ:** 25559375

**Місцезнаходження:** 79031, м. Львів, вул. Стрийська, 202

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Держадміністрація

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Розмір організації:**

**Телефон:** (0322)635798

## **V. Відомості про співвиконавця ДіР**

## **VI. Відомості про ДіР**

**Назва роботи українською:**

Розроблення фізичних основ технології отримання гетероструктур на основі арсенід-галієвих матеріалів методом МОС-гідридної епітаксії для отримання фотовольтаїчних елементів з високим ККД

**Назва роботи англійською:**

Development of physical principles of technology of receipt of heterostructures on the basis of gallium-arsenide materials by the method of MOS hydride epitaxy for the receipt of high-efficiency photovoltaic elements

**Мета роботи українською:**

Розроблення фізичних основ технології виготовлення каскадних гетероструктур GaAs/AlGaAs/InGaP з варізонним активним шаром для фотовольтаїчних перетворювачів сонячної енергії методом газофазної епітаксії з металоорганічних з'єднань.

**Мета роботи англійською:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:** Нові речовини і матеріали

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Вид роботи:** 48 - прикладна

**Очікувані результати:** Технології

**Галузь застосування:** 73.10.1 "Дослідження і розробки в галузі природничих наук"

**Керівники роботи**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:** Круковський Семен Іванович

**Науковий ступінь:**

**Вчене звання:**

**Ідентифікатор ORCID ID:**

**Додаткова інформація:**

## **VII. Етапи виконання ДіР**

**Номер етапу:** 1

**Назва етапу:** Розроблення фізичних основ технології отримання гетероструктур на основі арсенід-галієвих матеріалів методом МОС-гідридної епітаксії для отримання фотовольтаїчних елементів з високим ККД.

**Початок етапу:** 07.2010

**Закінчення етапу:** 12.2011

**Вид звітнього документа:** Остаточний звіт

## **VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ**

**Індекс УДК:** 621.315.616.95/.96; 621.315.616.97; 621.315.616-419, 621.315.592

**Коди тематичних рубрик:** 47.09.53

## **IX. Заключні відомості**

**Керівник юридичної особи**

Луговський Віктор Володимирович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Телефон**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.